



Home



Search



List

☐ Include

## MicroPatent® PatSearch FullText: Record 1 of 1

Search scope: US EP WO JP; Full patent spec.

Years: 1990-2001

Text: Patent/Publication No.: WO9825298

[no drawing available]

[Download This Patent](#)[Family Lookup](#)[Go to first matching text](#)

WO9825298

SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD FOR MANUFACTURE THEREOF, CIRCUIT BOARD,  
AND ELECTRONIC EQUIPMENT  
SEIKO EPSON CORPORATION

Inventor(s): HASHIMOTO, Nobuaki

Application No. JP9704438, Filed 19971204, A1 Published 19980611

**Abstract:** A semiconductor device whose package size is nearly the same as the size of a chip, and which can effectively absorb thermal stress in addition to a stress absorbing layer. A semiconductor device (150) has semiconductor chip having an electrode (158), a resin layer (152) formed as a stress reducing layer on the semiconductor chip, an interconnect (154) which is formed on the entire surface including the electrode (158) and the resin layer (152), and a solder ball (157) which is formed on a part of the interconnect (154) which is formed on the resin layer (152). The resin layer (152) is so formed as to have a recess (152a) on its surface and the interconnect (154) is so formed as to also cover the entire surface including the recess (152a).

Int'l Class: H01L0213205; H01L02160

Priority: JP 8/339045 19961204 ; JP 8/356880 19961226

Designated States: AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY CA CH CN CU CZ DE DK EE ES FI  
GB GE GH HU ID IL IS JP KE KG KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MD MG MK MN MW MX NO  
NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT UA UG US UZ VN YU ZW GH KE LS MW  
SD SZ UG ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU  
MC NL PT SE BF BJ CF CG CI CM GA GN ML MR NE SN TD TG



Home



Search



List

☐ Include

For further information, please contact:

[Technical Support](#) | [Billing](#) | [Sales](#) | [General Information](#)

E556A

⑤

(19) 日本国特許庁 (J P)

再公表特許 (A 1)

(11) 国際公開番号

WO 98 / 2 5 2 9 8

発行日 平成11年(1999) 4 月 6 日

(43) 国際公開日 平成10年(1998) 6 月 11 日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

H 0 1 L 21/3205  
21/60

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求(全 53 頁)

出願番号 特願平10-523489  
(21) 国際出願番号 P C T / J P 9 7 / 0 4 4 3 8  
(22) 国際出願日 平成 9 年 (1997) 12 月 4 日  
(31) 優先権主張番号 特願平8-339045  
(32) 優先日 平 8 (1996) 12 月 4 日  
(33) 優先権主張国 日本 (J P)  
(31) 優先権主張番号 特願平8-356880  
(32) 優先日 平 8 (1996) 12 月 26 日  
(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 セイコーエプソン株式会社  
東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号  
(72) 発明者 橋元 伸晃  
長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内  
(74) 代理人 弁理士 井上 一 (外 2 名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器

(57) 【要約】

パッケージサイズがチップサイズに近く、応力吸収層とは別に、熱ストレスを効果的に吸収することができる半導体装置である。半導体装置 (150) は、電極 (158) を有する半導体チップと、半導体チップの上に設けられる応力緩和層としての樹脂層 (152) と、電極 (158) から樹脂層 (152) の上にかけて形成される配線 (154) と、樹脂層 (152) の上方で配線 (154) に形成されるハンダボール (157) と、を有し、樹脂層 (152) は表面に窪み部 (152a) を有するように形成され、配線 (154) は窪み部 (152a) の上を通過して形成される。

FIG.14A

